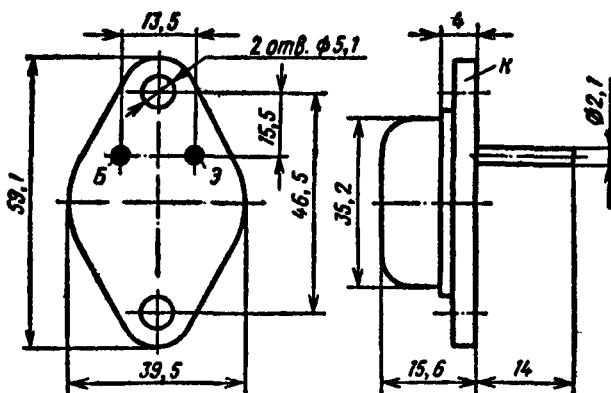


КТ710А

Транзистор кремниевый мезапланарный структуры *n-p-n* импульсный. Предназначен для применения в высоковольтных стабилизаторах и импульсных устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 61 г.

КТ710А



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 4$ А, не менее:

$T_n = +25^\circ\text{C}$	2,5
$T_n = -60$ и $+100^\circ\text{C}$	1,5
Граничное напряжение при $I_K = 0,1$ А, $L = 40$ мГн, не менее	1000 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 4$ А, $I_B = 3$ А, не более	3,5 В
Время спада при $U_{КЭ} = 750$ В, $I_K = 4,5$ А, $I_B = 1,8$ А, $U_{БЭ} = 5$ В, типовое значение	8* мкс
Время рассасывания при $U_{КЭ} = 750$ В, $I_K = 4,5$ А, $I_B = 1,8$ А, $U_{БЭ} = 5$ В, типовое значение	30* мкс
Обратный ток коллектора, не более:	
$T = +25^\circ\text{C}$, $U_{КБ} = 3000$ В	2 мА
$T = +100^\circ\text{C}$, $U_{КБ} = 1000$ В	3 мА
$T = -60^\circ\text{C}$, $U_{КБ} = 1000$ В	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В, не более	300* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база ¹ при $T_n = -40...+75^\circ\text{C}$	3000 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер ¹ при $R_{БЭ} = 10$ Ом, $t_{\phi} \geq 4,8$ мкс, $T_n = -40...+75^\circ\text{C}$	3000 В
Постоянное напряжение база — эмиттер $I_{БЭ} = 300$ мА	5 В
Постоянный ток коллектора	5 А
Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мс, $Q \geq 5$	7,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ² при $T_n = -60...+50^\circ\text{C}$	50 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $T_n = +25^\circ\text{C}$, $T_n = +125^\circ\text{C}$, $t_u \leq 10$ мс, $Q \geq 5$	70 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	$+125^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	$-60^\circ\text{C}...T_n = +100^\circ\text{C}$

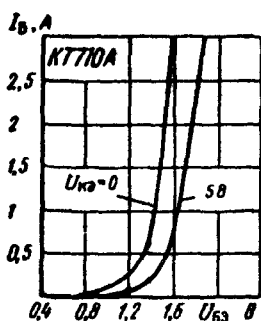
¹ При $T_n = +75...+100^\circ\text{C}$ и $T_n = -40...-60^\circ\text{C}$ $U_{КБ, макс}$ и $U_{КЭВ, макс}$ уменьшаются линейно до $U_{КЭВ, ср}$.

² При $T_n = +50...+100^\circ\text{C}$ $P_{К, макс}$ рассчитывается по формуле $P_{К, макс} = (125 - T_n) / R_{T(n-k)}$.

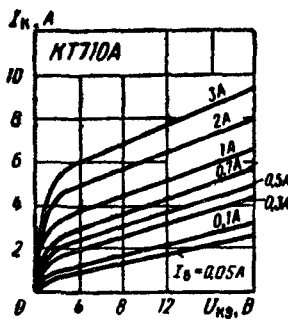
При конструировании аппаратуры следует учитывать возможность самовозбуждения за счет паразитных связей.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

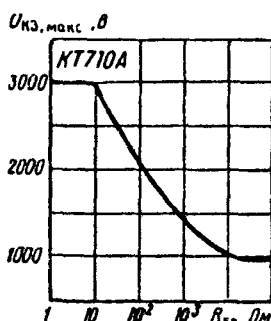
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре припоя $+260^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с.



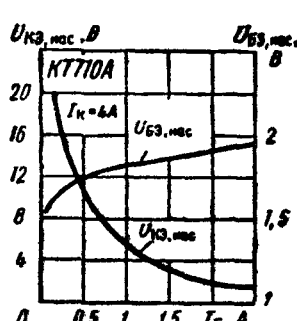
Входные характеристики



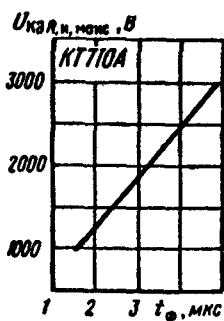
Выходные характеристики



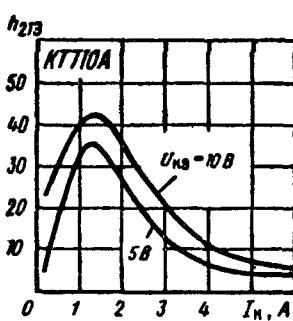
Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



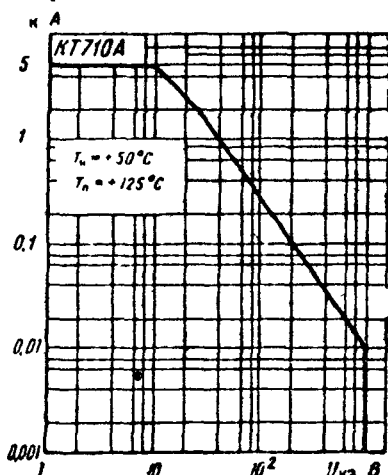
Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока базы



Зависимость максимально допустимого импульсного напряжения коллектор — эмиттер от длительности фронта



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Область максимальных режимов